

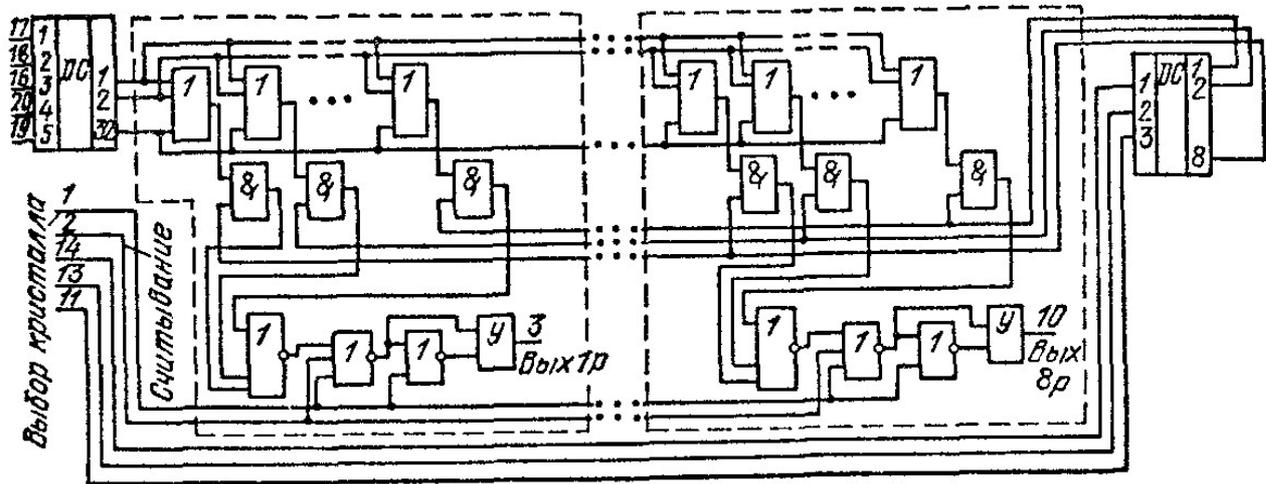
К501РЕ1П, КР501РЕ1

Постоянное запоминающее устройство 2048 бит (256 слов x 8 разрядов), тип логики: МОП-структуры (р-канальные).

Корпус прямоугольный пластмассовый 209.24-3.

Выводы: общий — 12; —Uип₁ — 24; Uип₂ — 23.

Напряжение источника питания: Uип₁ = —12 В±10%; Uип₂ = —27 В±10%.



Электрические параметры

Входное напряжение низкого уровня	> -2 В
Входное напряжение высокого уровня	< -8,5 В
Выходное напряжение низкого уровня	> -1 В
Выходное напряжение высокого уровня	< -10 В
Входной ток высокого уровня	< 5 мкА
Выходной ток	< 50 мкА
Ток потребления Iпот ₁ , не более	22 мА
Ток потребления Iпот ₂ , не более	4,5 мА
Частота команды считывания, не более	10 кГц
Время задержки команды считывания относительно входа адреса	< 2 мкс
Время считывания	
t ⁰ _{сч} , не более	2,5 мкс
t ¹ _{сч} , не более	4,5 мкс
Время выключения	
t ⁰ _{выкл} , не более	1,5 мкс
t ¹ _{выкл} , не более	2 мкс
Время цикла, не более	6 мкс
Время перехода микросхемы из состояния «0» в состояние «1»	< 3,5 мкс
Время перехода микросхемы из состояния «1» в состояние «0»	< 3 мкс
Емкость логических входов, не более	20 пФ
Емкость выходов, не более	11 пФ

Предельно допустимые электрические режимы эксплуатации

Напряжение положительной полярности на любом выводе, не более	0,3В
Напряжение источника питания:	
Uип ₁ , не менее	—15 В
Uип ₂ , не менее	—30 В
Входное напряжение, не менее	—30 В
Выходное напряжение, не менее	—25 В
Мощность рассеивания, не более	450 мВт
Допустимое значение статического потенциала на выводах, не более	30 В

Условия применения

Температура окружающей среды	-45...+70 °С
Многократное циклическое изменение температур	-45...+70 °С
Относительная влажность воздуха при +25 °С	98%
Синусоидальная вибрация (1-600 Гц)	10 g
Многократные удары с ускорением	75 g
Линейное ускорение	25 g

Номера 8-разрядных ячеек накопителя ПЗУ К501РЕ1П от 0 до 255 являются десятичным выражением двоичного кода $x_0*x_1*x_2*x_3*x_4*y_1*y_2*y_3$ на адресных входах микросхемы, где y_2 - младший разряд числа $x_0*x_1*x_2*x_3*x_4*y_1*y_2*y_3$, а x_1 — старший разряд.

Допускается ток нагрузки до 1 мА в состоянии «0» без регламентации уровня. Допускается выходное напряжение —6,5 В в состоянии «1» при подключении резистора $R_n = 13$ кОм между контролируемым и общим выводами микросхем.